

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 品田高宏 副委員長 平野博茂

幹事 池田浩也・諸岡 哲 幹事補佐 森 貴洋・小林伸彰

◎本研究会は参加費が必要になります。

エレソの技報電子化研究会に関する御案内ページ

<https://www.ice.org/es/jpn/e-gihou-2018es/e-gihou-2018es.htm>

日時 1月29日(火) 9:30~16:05

会場 機械振興会館地下3階研修2号室(港区芝公園3-5-8, 東京メトロ日比谷線; 神谷町駅下車, 徒歩8分. <http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>)

議題 先端 CMOS デバイス・プロセス技術 (IEDM 特集)

1. [招待講演] 強誘電体のマルチドメインを考慮した負性容量トランジスタの動作特性解析 太田裕之 (産総研)
2. [招待講演] 強誘電体トランジスタで観測される急峻スロープ特性の解析 右田真司 (産総研)
3. [招待講演] 負性容量効果をどのように理解するか 鳥海 明 (東大)
4. [招待講演] The Relation between Polarization Switching and Subthreshold Behavior in HfO<sub>2</sub>-based Ferroelectric and Anti-ferroelectric FET: An Experimental Study Chengji Jin (Univ. of Tokyo)
5. [招待講演] Sub 20 nm Scalability Demonstration of Ferroelectric-HfO<sub>2</sub> Tunnel Junction Memory Based on Non-equilibrium Green Function Method with Self-consistent Potential Fei MO (Univ. of Tokyo)

午後 (13:20~)

6. [招待講演] Highly Reliable Ferroelectric Hf<sub>0.5</sub>Zr<sub>0.5</sub>O<sub>2</sub> Film with Al Nanoclusters Embedded by Novel Sub-Monolayer Doping Technique 山口 直 (ルネサス エレクトロニクス)
7. [招待講演] HfO<sub>2</sub>/SiO<sub>2</sub> MOS 積層構造を用いた界面ダイポール変調型メモリ 宮田典幸 (産総研)
8. [招待講演] 14 ns write speed 128 Mb density Embedded STT-MRAM with endurance > 10<sup>10</sup> and 10 yrs retention @85°C using novel low damage MTJ integration process 佐藤英夫 (東北大)
9. [招待講演] Half pitch 14 nm direct patterning with Nanoimprint lithography 中杉哲郎 (東芝メモリ)
10. [招待講演] 固体量子情報デバイスの実現に向けたシリコン同位体技術 宮本 聡 (慶大)
11. [招待講演] 5 V ゲート駆動 1200 V 級スケーリング IGBT の動作実証とスイッチング損失の低減 更屋拓哉 (東大)

◆応用物理学会共催

☆SDM 研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

2月7日(木) 東大 [締切済] テーマ: 配線・実装技術と関連材料技術

【問合先】

諸岡 哲 (東芝メモリ)

TEL [059] 390-7451, FAX [059] 361-2739

E-mail: [tetsu.morooka@toshiba.co.jp](mailto:tetsu.morooka@toshiba.co.jp)